

## Ultra-Fast Recovery Rectifier Diodes

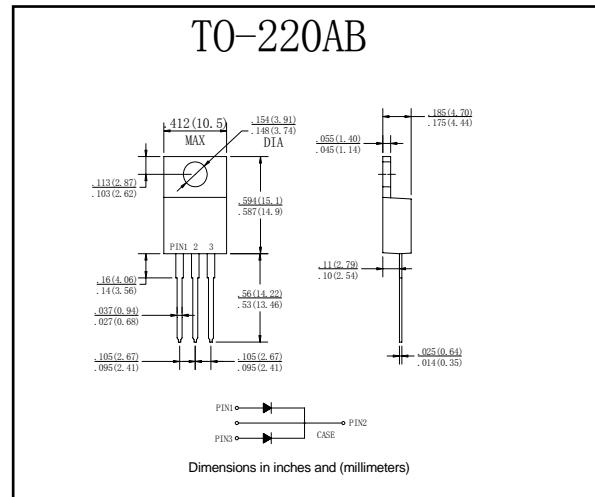
### ■ 特征 Features

- $I_o$  10.0A
- $V_{RRM}$  100V~600V
- 玻璃钝化芯片 Glass passivated chip
- 耐正向浪涌电流能力高  
High surge forward current capability

### ■ 用途 Applications

- 快速整流用  
High speed switching

### ■ 外形尺寸和印记 Outline Dimensions and Mark



### ■ 极限值 (绝对最大额定值)

#### Limiting Values (Absolute Maximum Rating)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Conditions	MUR-CT				
				1010	1015	1020	1040	1060
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	V		100	150	200	400	600
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	$I_o$	A	60Hz 正弦波, 电阻负载, $T_a=25^\circ C$ 60Hz sine wave, R-load, $T_a=25^\circ C$			10		
正向(不重复)浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	$I_{FSM}$	A	60Hz正弦波, 一个周期, $T_a=25^\circ C$ 60Hz sine wave, 1 cycle, $T_a=25^\circ C$			55		
正向浪涌电流的平方对电流浪涌持续时间的积分值 Current Squared Time	$I^2t$	$A^2s$	$1ms \leq t < 8.3ms$ $T_j=25^\circ C$ , 单个二极管 $1ms \leq t < 8.3ms$ $T_j=25^\circ C$ , Rating of per diode			12		
贮存温度 Storage Temperature	$T_{stg}$	°C				-55 ~ +150		
结温 Junction Temperature	$T_j$	°C				-55 ~ +175		

### ■ 电特性 ( $T_a=25^\circ C$ 除非另有规定)

#### Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ C$ Unless otherwise specified)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Test Condition	MUR-CT				
				1010	1015	1020	1040	1060
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	V	$I_{FM}=5.0A$		0.95		1.25	1.7
反向峰值电流 Peak Reverse Current	$I_{RRM1}$	$\mu A$	$V_{RM}=V_{RRM}$	$T_a=25^\circ C$		10		
	$I_{RRM2}$			$T_a=125^\circ C$		500		
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	$T_{rr}$	ns	$I_F=0.5A$ $I_{RM}=1A$ $I_{RR}=0.25A$		35		50	
热阻 Thermal Resistance	$R_{\theta J-C}$	°C/W	结和壳之间 Between junction and case		2.0			

## ■特性曲线（典型） Characteristics(Typical)

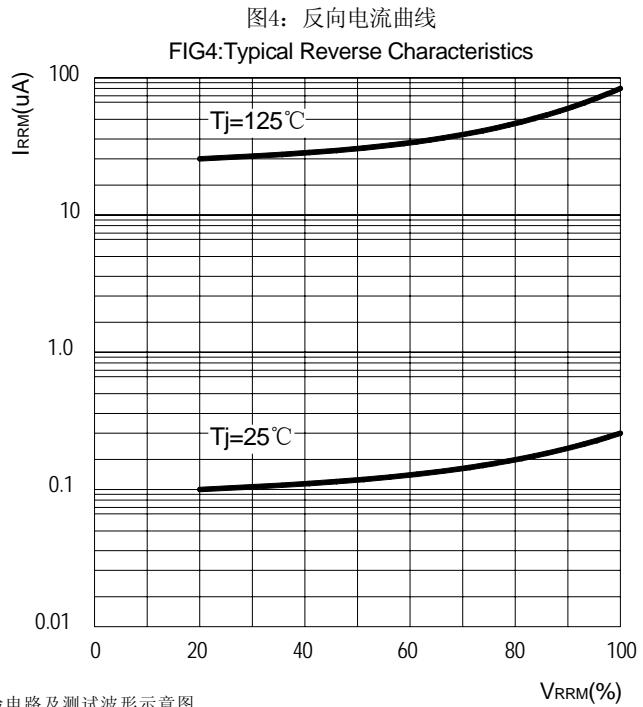
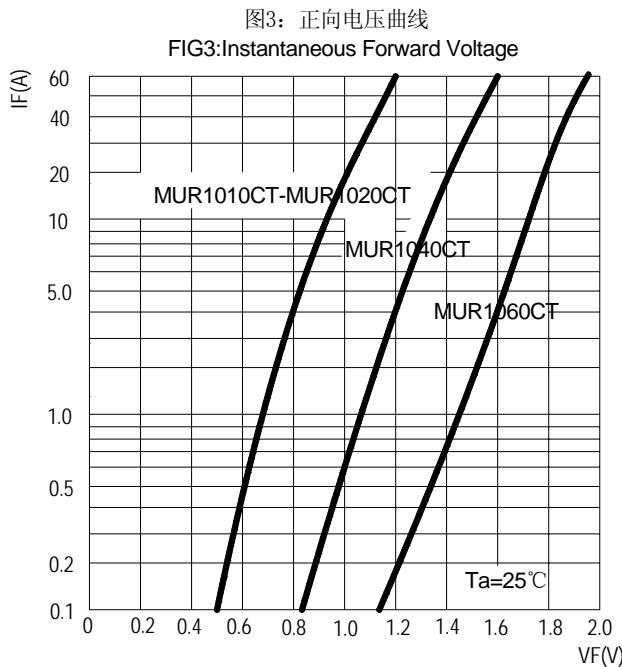
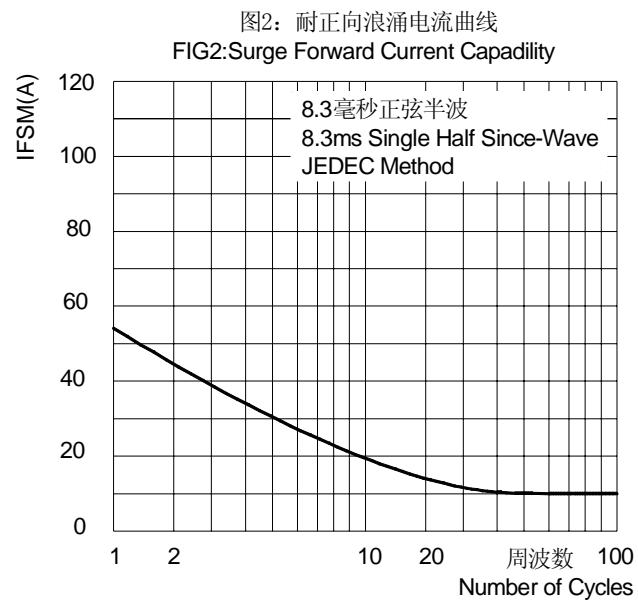
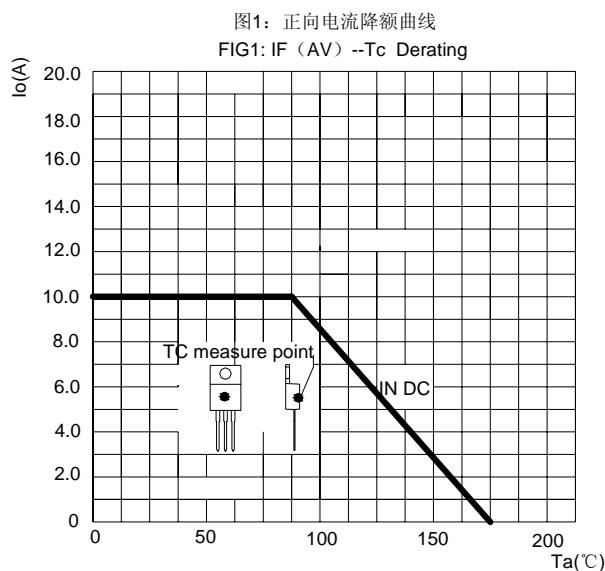


图5: 反向恢复时间试验电路及测试波形示意图  
FIG.5: Diagram of circuit and Testing wave form of reverse recovery time

